

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第3部門第1区分
【発行日】平成17年1月6日(2005.1.6)

【公開番号】特開2000-72488(P2000-72488A)
【公開日】平成12年3月7日(2000.3.7)
【出願番号】特願平10-242175
【国際特許分類第7版】
C 0 3 C 17/36
【F I】
C 0 3 C 17/36

【手続補正書】
【提出日】平成16年2月4日(2004.2.4)
【手続補正1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】

【請求項1】

ガラス基体上に、幾何学的膜厚が0.5～3nmのシリコンを主成分とする層と、幾何学的膜厚が3～50nmのカーボン主成分とする層とが順次形成されたことを特徴とする積層体。

【請求項2】

前記カーボンを主成分とする層が、水素をカーボンと水素の総量に対して5～20原子%含有する層である請求項1記載の積層体。

【請求項3】

前記カーボンを主成分とする層が、フッ素をカーボンとフッ素の総量に対して5～50原子%含有する層である請求項1または2記載の積層体。

【請求項4】

前記フッ素は、カーボンを主成分とする層の表面から3nm以内の層中に存在する請求項3記載の積層体。

【請求項5】

前記カーボンを主成分とする層の接触角が100°以上である請求項3または4記載の積層体。

【請求項6】

ガラス基体上に、幾何学的膜厚が0.5～3nmのシリコンを主成分とする層を形成し、次いで、幾何学的膜厚が3～50nmのカーボンを主成分とする層を形成することを特徴とする積層体の製造方法。

【請求項7】

ガラス基体上に、DCスパッタ法により、雰囲気中に水素を添加し、幾何学的膜厚が0.5～3nmのシリコンを主成分とする層を形成し、次いで、幾何学的膜厚が3～50nmのカーボンを主成分とする層を形成することを特徴とする積層体の製造方法。

【請求項8】

ガラス基体上に、幾何学的膜厚が0.5～3nmのシリコンを主成分とする層を形成し、次いで、DCスパッタ法により、雰囲気中にCF₄を添加し、幾何学的膜厚が3～50nmのカーボンを主成分とする層を形成することを特徴とする積層体の製造方法。

【請求項9】

ガラス基体上に、幾何学的膜厚が0.5～3nmのシリコンを主成分とする層を形成し、

次いで、DCスパッタ法により、アルゴンまたはアルゴン水素混合雰囲気で幾何学的膜厚が3～50nmのカーボンを主成分とする層を形成し、あとからCF₄雰囲気中でプラズマ処理することを特徴とする積層体の製造方法。